

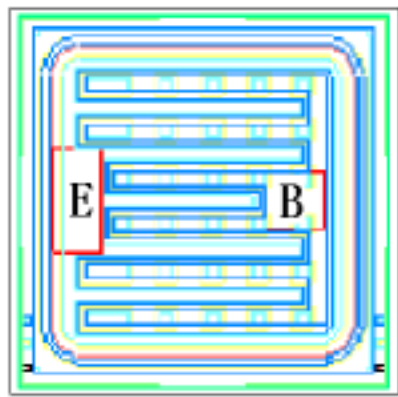


2383 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：C080BJ-01
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：800×800μm²
 焊位尺寸：B 极 124×124μm²；E 极 221×110μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2SC2383

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (TO-92L)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极功率耗散 (T_a=25)900mW
 V_{CB0}——集电极—基极电压.....160V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....160V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....6V
 I_C——集电极电流.....1A
 I_B——基极电流.....0.5A

电参数 (T_a=25) (TO-92L)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	160			V	I _C =100μA , I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	160			V	I _C =10mA , I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	I _E =100μA , I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			1	μA	V _{CB} =150V , I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	μA	V _{EB} =6V , I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	60		320		V _{CE} =5V , I _C =200 mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			1.5	V	I _C =500mA , I _B =50mA
V _{BE(on)}	基极—发射极饱和电压	0.45		0.75	V	V _{CE} =5V , I _C =5mA
f _T	特征频率	20	100		MHz	V _{CE} =5V , I _C =200mA
C _{ob}	共基极输出电容			20	pF	V _{CB} =10V , I _E =0 , f=1MHz